

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF **SCIENCE AND TECHNOLOGY (HUST)**



Khoa Vật lý Kỹ thuật

Faculty of Engineering Physics (SEP)

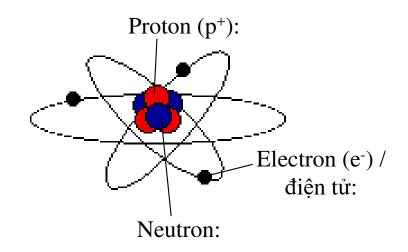
CHUONG I TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH

- 1.1 Mở đầu
- 1.2 Định luật Coulomb
- 1.3 Điện trường
- 1.4 Định lý Gauss
- 1.5 Điện thế
- 1.6 Cường độ điện trường và điện thế

1.1 Mở đầu

1.1.1 Điện tích

- Diện tích: thuộc tính tự nhiên của những hạt cơ bản có kích thước rất nhỏ (không thể nhìn thấy bằng mắt thường) tạo ra liên kết về điện trong nguyên tử (phần tử cơ sở = nguyên tố) hình thành lên thế giới vật chất.
- Cấu trúc nguyên tử:
- \blacklozenge Hạt nhân (lõi ở chính giữa) coi như cố định, có các hạt mang điện tích (+), proton, ký hiệu p^+ và hạt neutron ko điện tích.
- ♦ Vỏ gồm các hạt mang điện tích (–), electron (e⁻) xung quanh sắp xếp theo từng lớp tuân theo quy luật nhất định.



- \blacklozenge Trạng thái bình thường: số e và p cân bằng \Rightarrow trung hòa điện
- \bullet e^- luôn di chuyển \Rightarrow có thể gây ra sự mất cân bằng điện tích, khi 2 hay nhiều nguyên tử tiếp xúc với nhau \Rightarrow tạo ra các i-ôn mang điện tích (+) hoặc (-);
- Diện tích điểm:
- ♦ Điện tích có kích thước không đáng kể so với khoảng cách từ điện tích đến một điểm nào nào đó trong không gian nằm trong vùng ảnh hưởng của nó.

1.1 Mở đầu

1.1.2 Tính chất điện tích

Thiện tích nguyên tố (giá trị của đơn vi điện tích) = $1.6x10^{-19}$ C.

Hạt cơ bản	Khối lượng	Điện tích
Electron	9,11.10 ⁻³¹ kg	-1,60.10 ⁻¹⁹ C (-e)
Proton	1,672.10 ⁻²⁷ kg	+1,60.10 ⁻¹⁹ C (+p)
Neutron	1,674.10 ⁻²⁷ kg	0

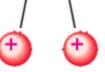
Điện tích của vật tích điện: Đại lượng vô hướng xác định bằng một số nguyên lần (= sự chênh lệch số các p+ và e- trong vật thể) điện tích nguyên tố,

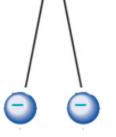
tức là, $Q = e.(N_p-N_e) = n.e.$

♦ Điện tích dương: **(** •)

♦ Điện tích âm: 🧲











Cảm ứng (điện hưởng)

Truyền điện tích

• Bảo toàn điện tích: điện tích không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ dịch chuyển bên trong một vật hoặc từ vật này sang vật khác.





Ma sát (tiếp xúc)

Dẫn điện

1.2.1 Thực nghiệm

- Cân xoắn Coulomb
- 2 quả cầu kim loại gắn cách nhau khoảng L, treo trong hộp thủy tinh kín bằng dải lụa mảnh.;
- ♦ Một vành tròn chia độ đều (0-360°) gắn bên trong hộp thủy tinh tương ứng vị trí 2 quả cầu.



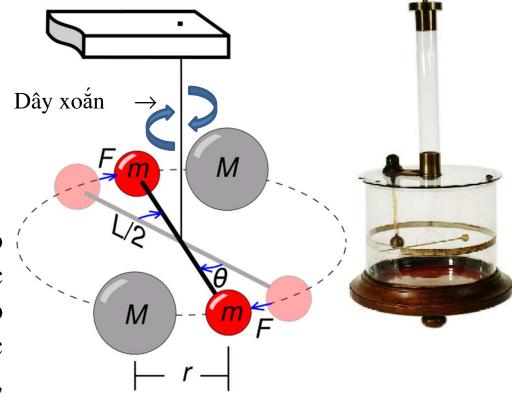
Charles-Augustin de Coulomb (1736 – 1896)

TN xác định tương tác tĩnh điện:

• Dùng lực kế lò xo tác động để dây xoắn: biết F, đo góc $\theta \Rightarrow x/\bar{d}$ được hệ số đàn hồi xoắn k;

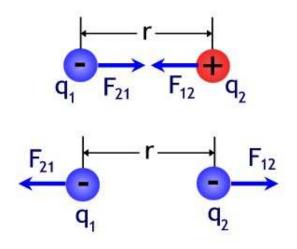
$$\mathbf{M} = F.\frac{L}{2} = k.\theta$$

♦ Tích điện cho quả cầu treo, sau đó dùng 1 quả cầu khác (M) cũng được tích điện đưa gần tới quả cầu treo ($kh/cách\ r$) \Rightarrow xuất hiện tương tác tĩnh điện (hút hoặc đầy): đã biết k, đo góc $\theta \Rightarrow x/d$ được F.



1.2.2 Nội dung

- Phát biểu
- igoplus Lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích q_1 , q_2 , đặt trong chân không, có phương nằm trên đường thẳng nối 2 điện tích, có chiều phụ thuộc vào dấu 2 điện tích, có độ lớn tỷ lệ thuận tích số q₁, q₂ và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.



$$|F| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Tổng quát:
$$ec{F}=$$

Tổng quát:
$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

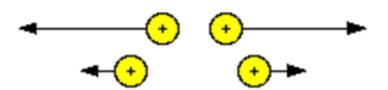
Hệ số tỉ lệ:
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}$$

Trong chân không và KK:
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Vói:
$$\varepsilon_0 = 8,85.10^{-12} \frac{C^2}{N.m^2}$$

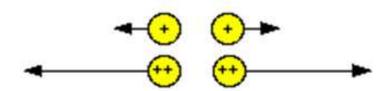
1.2.2 Nội dung

- Lực Coulomb $|F| = \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$ phụ thuộc:
- khoảng cách;



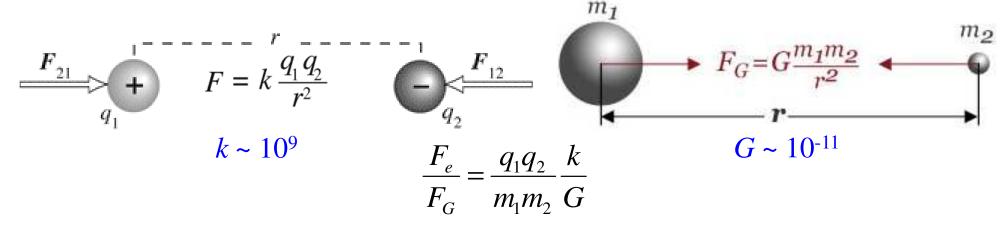
Gấp đôi khoảng cách, lực giảm 1/4

• độ lớn các điện tích.



Gấp đôi điện tích, lực tăng 4 lần

Lực Coulomb và lực hấp dẫn



♦ Đ/v electron: $q = 1,6.10^{-19}$ C, $m = 9,31.10^{-31}$ kg $\Rightarrow \frac{F_e}{F_G} = 4,17.10^{42}$

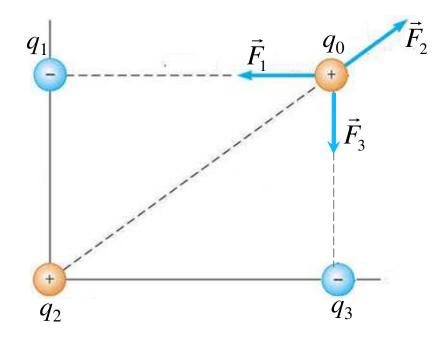
1.2.3 Nguyên lý chồng chất lực

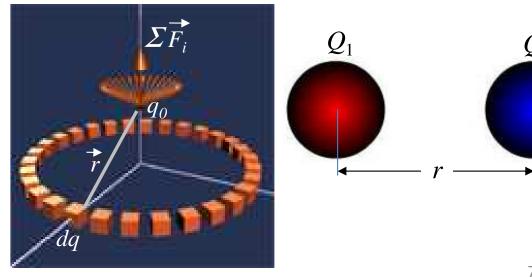
 $\ ^{\circ}$ Xét đ/tích q_0 chịu tác dụng của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$ bởi hệ đ/tích $q_1, q_2, ..., q_n$

Tương tác tổng cộng của hệ điện tích lên q_0 : $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i}$

đ/tích q_0 chịu tương tác tĩnh điện của vật bất kỳ (vòng tròn) mang đ/tích $q \Rightarrow$ chia nhỏ q thành các điện tích vô cùng nhỏ dq, sao cho, dq được coi là đ/tích điểm \Rightarrow lực tác dụng lên $q_0 \Leftrightarrow$ lực tổng hợp của các đ/tích dq lên q_0 .

$$F = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{(V)} \frac{dq}{r^2}$$





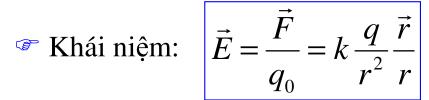
1.3.1 Khái niệm

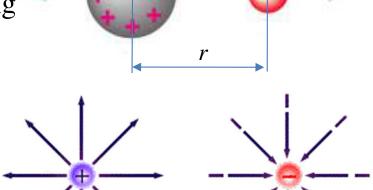
- Trường: Không gian mà một đại lượng vật lý được xác định tại mỗi điểm trong đó.
 - ♦ Đại lượng vector ⇒ trường vector;
- → Đại lượng vô hướng ⇒ trường vô hướng.
- Diện trường: khoảng không gian bao quanh các điện tích, thông qua đó tương tác (lực) tĩnh điện được xác định.
 - ♦ Tương tác giữa 2 điện tích điểm được truyền đi không tức thời (v hữu hạn);
- ♦ Tương tác diễn ra thông qua sự tham gia của môi trường trung gian;
- ♦ Điện trường xung quanh điện tích: giữ vai trò truyền tương tác.
- ♦ Điện trường là trường vector (do ~ với vector lực).

1.3.2 Vector cường độ điện trường

- Tét điện tích $q_0 = +1C$ (đ/tích thử) đặt trong điện trường của đ/t điểm q, cách q 1 khoảng r.
- ♦ Lực Coulomb

$$\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = q_0 \left(k \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \right) = q_0 \cdot \vec{E}$$





Điện tích thử

♦ Cường độ điện trường tại 1 điểm nào đó là đại lượng vật lý có độ lớn bằng độ lớn của lực điện trường tác dụng lên 1 đơn vị điện tích +1C đặt tại điểm đó.

• Độ lớn:
$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi ε ε_0} \frac{q}{r^2} = 9.10^9 \frac{q}{r^2}$$

- ♦ Ý nghĩa: Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực (mạnh, yếu) của điện trường tại các vị trí không gian khác nhau trong đó.
- ♦ Đơn vị: N/C hoặc V/m.

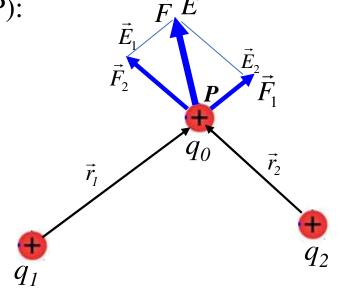
1.3.3 Nguyên lý chồng chập điện trường

Tát q_1 , q_2 tác dụng lực \vec{F}_1 , \vec{F}_2 lên q_0 (đặt tại P):

• có:
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$
 $\Rightarrow \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0}$

 \blacklozenge Điện trường gây bởi q_1 và q_2 :

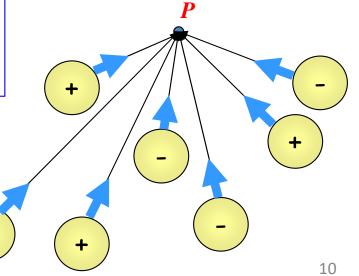
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \frac{\vec{r}_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2^2} \frac{\vec{r}_2}{r_2} \right)$$



Tiện trường gây bởi *n* điện tích điểm tại vị trí bất kỳ (P) trong không gian:

$$\vec{E}_{P} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_{i}}{r_{i}^{2}} \frac{\vec{r}_{i}}{r_{i}}$$

♦ Vector cường độ điện trường gây bởi một hệ điện tích tại bất kỳ điểm nào trong trường là tổng các vector cường độ điện trường gây bởi từng điện tích tại điểm đó.



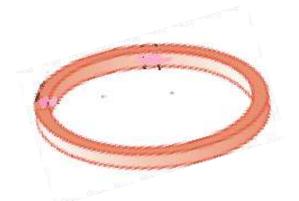
1.3.3 Nguyên lý chồng chập điện trường

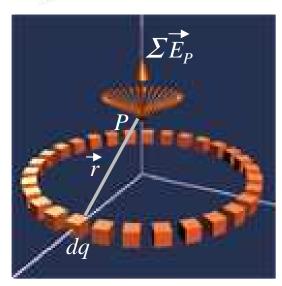
- Diện trường gây bởi vật mang điện, có điện tích phân bố liên tục:
- \blacklozenge Điện trường gây bởi dq tại 1 điểm cách dq đoạn r:

$$d\vec{E}_P = \frac{9.10^9}{\mathcal{E}} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

♦ Điện trường tổng hợp gây bởi toàn bộ vật mang điện tại 1 điểm trong không gian của điện trường:

$$\vec{E}_P = \int_{toàn \ b\hat{o} \ v\hat{a}t} d\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{toàn \ b\hat{o} \ v\hat{a}t} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

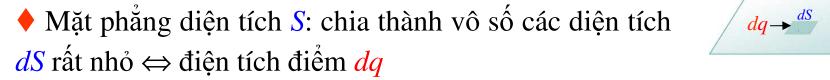




1.3.3 Nguyên lý chồng chất điện trường

- igoplus Dây dài l: chia thành vô số các độ dài dl rất nhỏ \Longleftrightarrow điện tích điểm dq

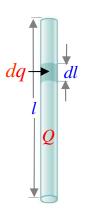
$$\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(l)}^{l} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \qquad (\lambda = Q/l: \text{ mật độ điện dài})$$

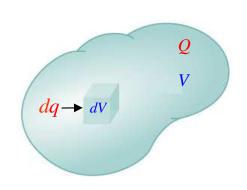


$$\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(S)} \frac{\sigma dS}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \qquad (\sigma = Q/S: \text{ mật độ điện mặt})$$

♦ Khối thể tích V: chia thành vô số các thể tích dV rất nhỏ \Leftrightarrow điện tích điểm dq

$$\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \qquad (\rho = Q/V: \text{ mật độ điện khối})$$





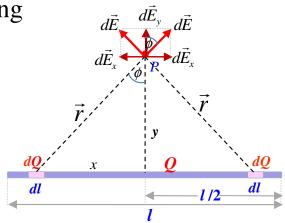
1.3.3 Nguyên lý chồng chất điện trường

- igoplus Điện trường gây bởi mỗi dQ, độ dài dl tại P:

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$$

Điện trường tổng hợp tại P của dây:

$$\vec{E} = \int_{-l/2}^{+l/2} d\vec{E}_x + \int_{-l/2}^{+l/2} d\vec{E}_y$$



- Các thành phần dE_x của dE gây bởi từng cặp dQ, có cùng trị số, ngược chiều nhau ở 2 phía trục dây \Rightarrow tổng hợp vector = 0.
- thành phần $dE_{iy} = dE_i \cos \phi$

$$ightharpoonup$$
 khi $y \ll l \implies E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda}{y}$ và $y >> l \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{y^2}$

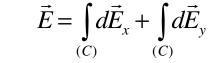
1.3.3 Nguyên lý chồng chất điện trường

- \bigcirc Dây tích điện (\bigcirc), cuộn thành vòng tròn, bán kính R, chu vi $C = 2\pi R$, đặt trong không khí \Rightarrow điện trường tại P, nằm trên trục cách tâm vòng dây khoảng h?
- \bullet Điện trường gây bởi mỗi dQ, độ dài dl tại P:

$$d\vec{E}_i = d\vec{E}_{ix} + d\vec{E}_{iy}$$

♦ Điện trường tổng hợp tại *P* của dây:

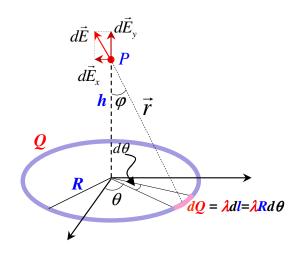
$$\vec{E} = \int_{(C)} d\vec{E}_x + \int_{(C)} d\vec{E}_y$$



- \blacklozenge Các thành phần dE_x của dE gây bởi Các dQ, có cùng trị số và đối Xứng quanh trục của vòng dây \Rightarrow tổng hợp vector = 0.
- thành phần $dE_y = dE\cos\varphi = \frac{h}{r}k\frac{dQ}{r^2} = kh\lambda R\frac{d\theta}{r^3}$

• có:
$$E = \frac{kh\lambda R}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \int d\theta = \frac{khQ}{(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

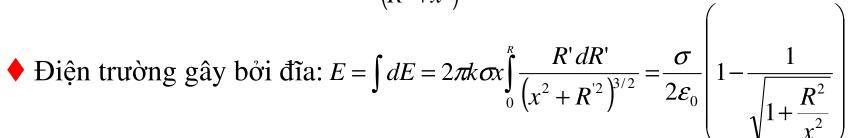
$$ightharpoonup$$
 khi $h \ll R \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R^3}$ và $h >> R \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{h^2}$



1.3.3 Nguyên lý chồng chất điện trường

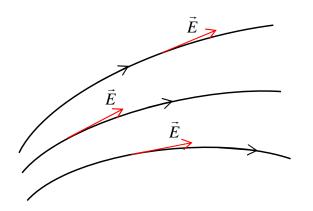
The Dia tròn bán kính R, điện tích Q, mật độ điện tích mặt σ , đặt trong không khí \Rightarrow điện trường tại P, nằm trên trục cách tâm đĩa khoảng x?

- Coi đĩa được thành bởi các phần tử hình vành khăn (giống dây tròn) bán kính R', bề dày dR có diện tích, $dS = \pi(R' + dR)^2 \pi R'^2 \approx 2\pi R' dR$ và điện tích $dQ = \sigma dS = 2\sigma \pi R' dR$.
- Điện trường gây bởi dQ: $dE = \frac{kxdQ}{(R'^2 + x^2)^{3/2}}$

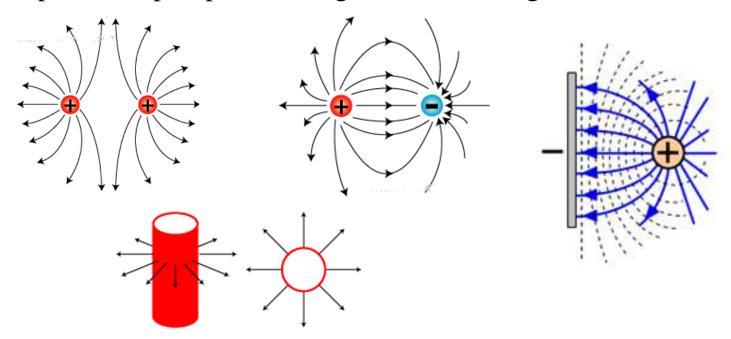


1.3.4 Đường sức điện trường

- Pinh nghĩa
- ♦ Các đường (thẳng hoặc cong) mô tả điện trường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trên các đường này trùng với phương của vector cường độ điện trường tại điểm đó.

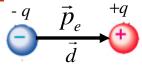


- ♦ Xuất phát từ điện tích/vật tích điện dương (+) đến vô cùng và từ vô cùng đến điện tích/vật tích điện âm (•).
- Diện phổ: hệ tập hợp các đường sức điện trường

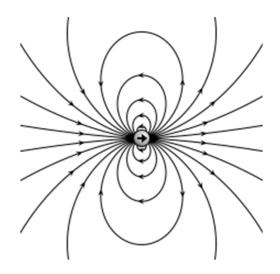


1.3.4 Lưỡng cực điện

Khái niệm



• Hệ 2 điện tích điểm trái dấu có độ lớn bằng nhau, cách nhau một khoảng d (rất nhỏ), đặc trưng bởi vector moment lưỡng cực: $\vec{p}_e = q\vec{d}$



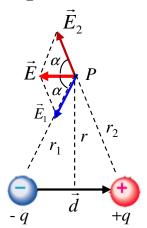
- Piện trường gây bởi lưỡng cực điện:
- ♦ Tại điểm nằm trên đường trung trực $(r_1 = r_2 \approx r >> d)$

có:
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

với: $E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$

Hay: $E = 2E_1 \cdot \cos \alpha$; $(\cos \alpha = d/2r_1)$

$$\Rightarrow \vec{E} = k \frac{q\vec{d}}{r^3} = k \frac{\vec{p}_e}{r}$$

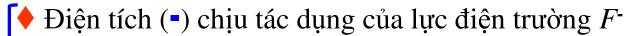


• Tại điểm nằm trên trục lưỡng cực (r >> d)

Có:
$$\vec{E} = k \frac{2\vec{p}_e}{r^3}$$

1.3.4 Lưỡng cực điện

Tướng cực điện trong điện trường đều, ở vị trí bất kỳ, tức là, $(\vec{p}_e, \vec{E}) = \theta$

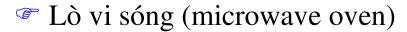


 \blacklozenge Điện tích (+) chịu tác dụng của lực điện trường F^+

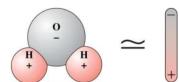
♦ Tạo ra moment lực $\vec{\mathcal{M}} = \vec{p}_e \times E$

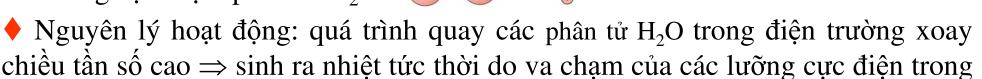
hay
$$\mathcal{M} = P_e E \cos \theta = q d E \cos \theta$$

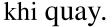
ightharpoonup thực hiện công xoay lưỡng cực điện cho đến khi $ec{p}_e \uparrow \uparrow ec{E}$

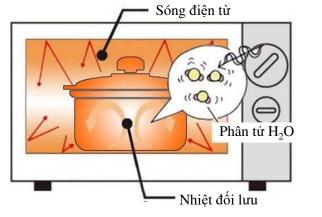


♦ Lưỡng cực điện: phân tử H₂O

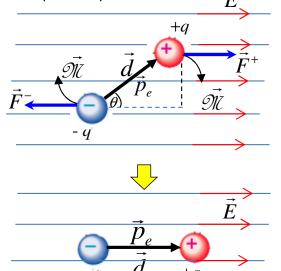












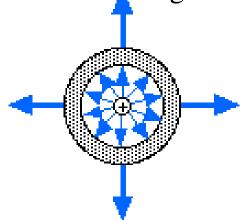


1.4.1 Các khái niệm cơ sở

Vector cường độ điện trường:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad \Rightarrow E \in \mathcal{E}$$

⇒ Phổ đường sức của vector điện trường gián đoạn khi qua mặt phân cách 2 môi trường

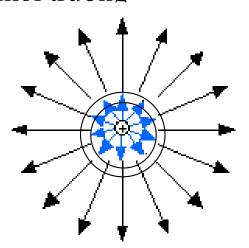


Johann Carl-Friederich Gauss (1777-1855)

Vector cảm ứng điện (điện cảm)

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \implies D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \notin \varepsilon$$

⇒ Phổ đường sức của vector điện cảm là liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường

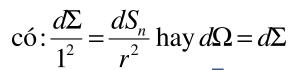


1.4.1 Các khái niệm cơ sở

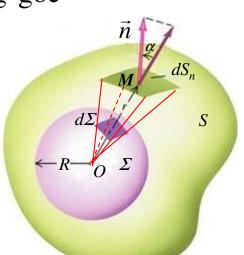
- Mặt kín
- Mặt bao xung quanh một không gian bên trong.



- Góc khối (góc trong không gian 3 chiều).
- ♦ Góc hướng từ 1 điểm đến một bề mặt (S) phía trước.
- Gốc khối vi phân: $d\Omega = \frac{dS_n}{r^2} = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$ $\begin{cases} -\alpha \text{ nhọn } \Rightarrow d\Omega > 0 \\ -\alpha \text{ từ } \Rightarrow d\Omega < 0 \end{cases}$
- Góc khối trong mặt kín: tại O dựng mặt cầu bán kính đ/vị, $R = 1 \Rightarrow d\Sigma$ trên mặt cầu nằm trong góc khối hướng từ O đến dS.



 \vec{n} hướng ra ngoài: $d\Omega = +d\Sigma$ \vec{n} hướng vào trong: $d\Omega = -d\Sigma$



 $dS_n = dS\cos\alpha$

1.4.2 Điện thông

- Pinh nghĩa
- ♦ Thông lượng vector điện là số đường sức của một điện trường đều, cắt vuông góc qua một thiết diện (S_O) ,

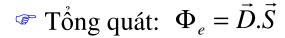
$$\Phi_{\rm e} = D.S_O$$

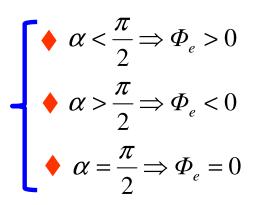
$$\alpha = (\vec{n}, \vec{D})$$

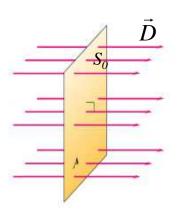
♦ Điện thông gửi qua *S*

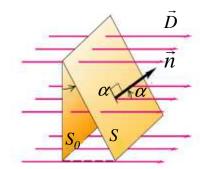
$$\Phi_{\rm e} = D.S_O = D.S.\cos\alpha = D_{\rm n}S$$

 $D_{\rm n}$ là hình chiếu của \vec{D} lên phương pháp tuyến \vec{n}





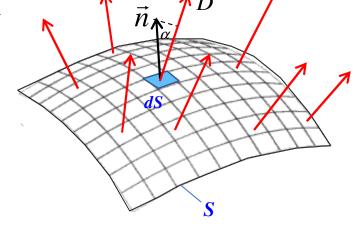




1.4.2 Diện thông

- Trường hợp đường sức điện trường bất kỳ cắt qua mặt *S* không phẳng.
- ♦ Chia mặt S thành vô số các phần tử diện tích vô cùng nhỏ dS, sao cho coi là phẳng, mà đường sức cắt qua mỗi dS như của điện trường đều.





♦ Điện thông gửi qua toàn bộ mặt S:

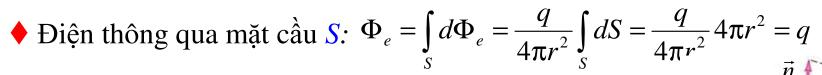
$$\Phi_e = \int_{(S)} d\Phi_e = \int_{(S)} D\cos\alpha dS = \int_{(S)} \vec{D}.d\vec{S}$$

- 🖤 Ý nghĩa: Đại lượng đặc trưng lượng điện trường đi qua một diện tích bề mặt.
- ❤ Đơn vị: N.m²/C

1.4.2 Điện thông

- Trường hợp điện tích điểm q bên trong một mặt cầu (S)
- ♦ Chia mặt cầu thành vô số phần tử diện tích rất nhỏ, coi là phẳng *dS*
- Luôn có: $\vec{n} \equiv \vec{D} \Rightarrow \alpha = 0$ và $\cos \alpha = 1$
- ♦ Điện thông gửi qua diện tích vi phân dS trên mặt cầu:

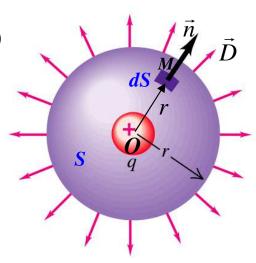
$$d\Phi_e = \vec{D}.d\vec{S} = DdS\cos\alpha$$



- Trường hợp điện tích q bên trong mặt kín S bất kỳ
- ♦ Điện thông qua mặt kín *S*:

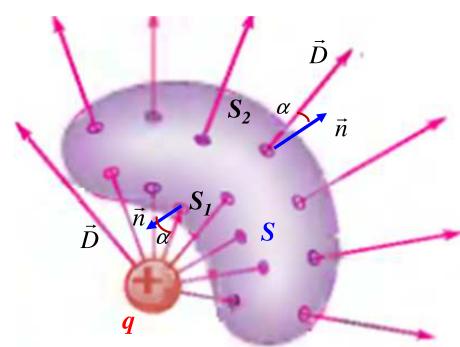
$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \frac{q}{4\pi} \int_{\Omega} dS \cos \alpha = \frac{q}{4\pi} \int_{\Omega} d\Omega = \frac{q}{4\pi} 4\pi = q$$

Mặt kín bao quanh điện tích điểm hoặc vật tích điện gọi là mặt Gauss



1.4.2 Điện thông

- Trường hợp điện tích q ở bên ngoài một mặt kín (S)
- igoplus Đường sức điện trường là đường hở \Longrightarrow hoặc không cắt hoặc cắt số chẵn lần (một đi vào mặt S_1 , một ra khỏi mặt S_2).
- Có: $\Phi_e = \frac{q}{4\pi} \int_S d\Omega$
- Với: $\int_{S} d\Omega = \int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega$
- $ightharpoonup S_1$ có \vec{n} hướng ngược chiều \vec{D}
- $ightharpoonup S_2$ có \vec{n} hướng cùng chiều \vec{D}
- $\oint \int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega = (-\Delta \Sigma) + (+\Delta \Sigma) = 0$
- ♦ Do đó $\Phi_e = 0 \Rightarrow$ bên trong mặt S không có điện trường.



1.4.3 Nội dung

- Phát biểu
- ♦ Thông lượng điện trường đi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.
 - Biểu diễn toán học
 - $igoplus Hệ điện tích phân bố rời rạc <math>\Phi_e = \oint_{(S)} D_n.dS = \sum_{i=1}^n q_i$
 - ♦ Vật tích điện có điện tích phân bố liên tục

$$\Phi_{e} = \oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{(V)} \rho \cdot dV$$

$$\text{vì: } \oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{V} div \vec{D} \cdot dV \qquad \text{oii: } div \vec{D} = \frac{\partial D_{x}}{\partial x} + \frac{\partial D_{y}}{\partial y} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$

Ý nghĩa: khẳng định đường sức điện trường tĩnh có dạng hở (không khép kín)

1.4.4 Tính điện trường bên trong và bên ngoài quả cầu rỗng tích điện

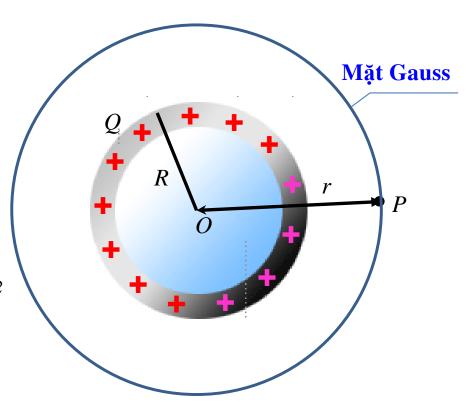
- $\ \ \,$ Điểm P bên ngoài, cách O khoảng r.
- Dựng mặt Gauss bao quanh, bán kính r > R.
- ♦ Thông lượng điện cảm qua mặt Gauss, bk *r*:

$$\Phi_e = \oint D_n . dS = \oint D . dS = D \oint dS = D . 4\pi . r^2$$

igoplus Định lý Gauss: $\Phi_e = Q$

$$D.4\pi . r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r^2}$$

• Cường độ điện trường bên ngoài quả cầu: $E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$



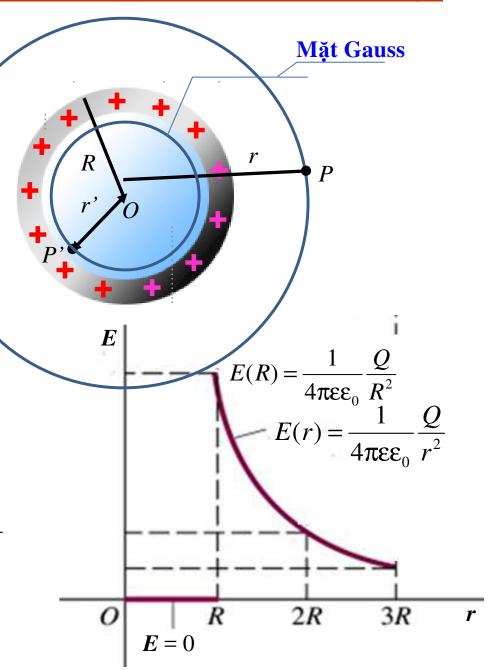
1.4.4 Tính điện trường bên trong và bên ngoài quả cầu rỗng tích điện

- $\ \ \,$ Điểm P' bên trong, cách O khoảng r'.
- ightharpoonup Dựng mặt Gauss sát mặt cầu, bán kính r' < R.
- ♦ Tương tự có:

$$D.4\pi r'^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r'^2}$$

- Bên trong q/cầu ko có điện tích, tức là $Q = 0 \Rightarrow E = 0$
- ♦ Tại bề mặt, r = R, có:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$

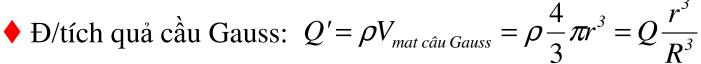


1.4.5 Tính điện trường bên trong và bên ngoài khối cầu đặc tích điện

Phân bố điện tích trong khối cầu (mật độ điện tích)

$$\rho = \frac{Q}{V_{kh\hat{o}i\ c\hat{a}u}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

- Điểm P bên trong, cách O khoảng r.
- igoplus Dựng mặt Gauss, bán kính r < R.

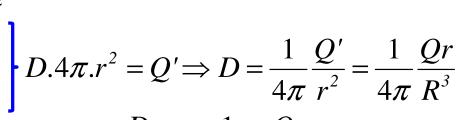


- ♦ Thông lượng điện cảm qua mặt Gauss, bk *r*:

$$\Phi_e = \oint D_n . dS = \oint D . dS = D \oint dS = D . 4\pi . r^2$$

 \blacklozenge Định lý Gauss: $\Phi_{\rho} = Q'$

Cường độ điện trường bên trong quả cầu:
$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Qr}{R^3}$$



Mặt Gauss

1.4.5 Tính diện trường bên trong và bên ngoài khối cầu đặc tích điện

- $\ \ \,$ Điểm P' bên ngoài, cách O khoảng r'.
- Dựng mặt Gauss bao quanh, bán kính r' > R.
- ♦ Tương tự có:

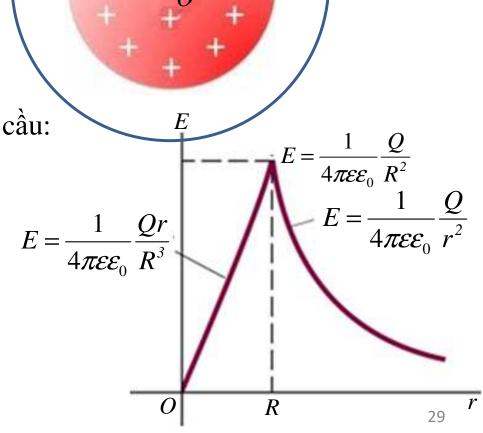
$$D.4\pi . r'^2 = Q \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{r'^2}$$

♦ Cường độ điện trường bên ngoài khối cầu:

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{r'^2}$$

Tại bề mặt: r = R:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$



Mặt Gauss

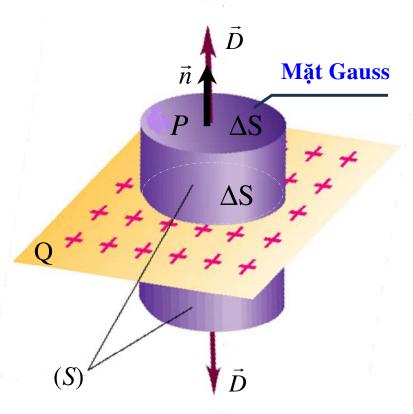
1.4.6 Tính điện trường xung quanh mặt phẳng tích điện

- Tại điểm P, dựng mặt kín S (Gauss) dạng trụ, có đường sinh cắt \bot mặt phẳng tích điện $\Rightarrow \vec{D} \bot$ mặt phẳng tích điện và 2 mặt đáy, ΔS là giao diện của trụ và mặt phẳng tích điện.
- ♦ Điện thông gửi qua mặt kín (S):

$$\varPhi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_{Mat\ b\hat{e}n} \vec{D} d\vec{S} + \int_{2Mat\ d\acute{a}y} \vec{D} d\vec{S}$$

$$\int \vec{D}d\vec{S} = 0 \text{ do } \vec{D} \perp \vec{n} \text{ và } \int \vec{D}d\vec{S} = D.\Delta S \text{ do } \vec{D} = 0$$
Mat bên

2 Mat đáy



♦ Theo định lý *Gauss*:
$$\Phi_e = Q \Rightarrow D_n = D = \frac{Q}{2\Delta S} = \frac{\sigma \Delta S}{2\Delta S} = \frac{\sigma}{2}$$
 hay $E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$

 $(\sigma = \text{mật độ điện tích mặt})$

1.4.6 Tính điện trường xung quanh mặt phẳng tích điện

- Thai mặt phẳng vô hạn song song tích điện bằng nhau, trái dấu (+Q và -Q)
- \bullet Điểm P ở giữa hai bản \Rightarrow có

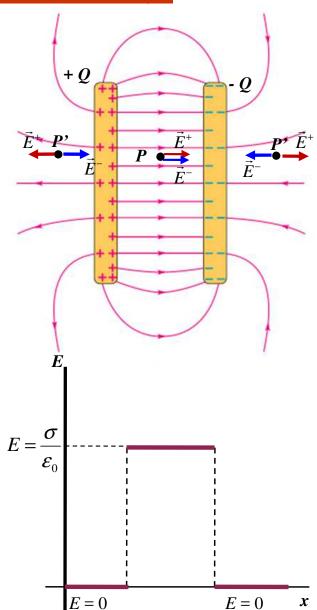
$$\vec{E}_P = \vec{E}^+ + \vec{E}^-$$
Trong đó:
$$E^+ = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{ vì } \vec{E} \uparrow \uparrow \vec{n}$$

$$E^- = -\frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{ vì } \vec{E} \uparrow \downarrow \vec{n}$$

Hai vector cùng chiều nên có

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

♦ Tại bất kỳ điểm P' bên ngoài hai mặt phẳng luôn có vector điện trưởng của mỗi mặt ngược chiều nhau ⇒ vector tổng hợp có trị số E_{P} = 0.



1.4.7 Điện trường xung quanh mặt trụ tích điện

Tại điểm P, dựng mặt kín S (mặt Gauss) dạng trụ, b/kính r > R, độ dài l, 2 đáy vuông góc trục, mặt bên bao quanh trục và $\vec{D} \perp$ bề mặt tại mọi điểm trên đó (tức là, \vec{D} // mặt đáy).

♦ Điện thông gửi qua mặt kín (S):

$$\Phi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_{Mat \ b \hat{e}n} \vec{D} d\vec{S} + \int_{2Mat \ d \acute{a} \acute{a} \acute{a} \acute{a} \acute{a}} \vec{D} d\vec{S}$$

$$\int_{2Mat\ day} \vec{D}d\vec{S} = 0\ \text{do}\ \vec{D} \perp \vec{n}\ \text{và}\ \int_{Mat\ b\hat{e}n} \vec{D}d\vec{S} = D.2\pi r l\ \text{do}\ \vec{D} //\ n$$

♦ Theo định lý *Gauss*:
$$\Phi_e = Q \Rightarrow D_n = D = \frac{Q}{2\pi rl}$$
 hay $E = \frac{R}{\epsilon \epsilon_0} \frac{Q}{r 2\pi Rl} = \frac{R}{\epsilon \epsilon_0} \frac{\sigma}{r}$

 $2\dot{r}$

♦ Khi
$$R$$
 rất nhỏ: $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{\lambda}{r}$ $\sigma = \frac{Q}{2\pi Rl} = \frac{Q}{S}$: mật độ điện mặt;

$$\lambda = \frac{Q}{l}$$
: mật độ điện dài.



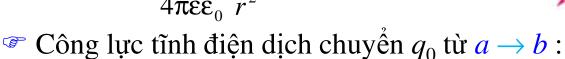
Mặt Gauss

(S)

1.5.1 Công của lực tĩnh điện – Tính chất thế trường tĩnh điện

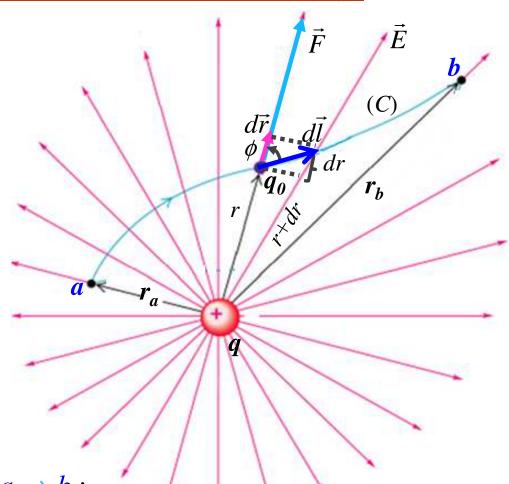
- Thiện tích q đứng yên tạo ra điện trường \vec{E}
- Thiện tích q_0 dịch chuyển trong \vec{E} từ $a \rightarrow b$ trên quĩ đạo (C) bất kỳ.
- Công lực F thực hiện trong dịch chuyển vô cùng nhỏ dl của q_0 trên ab:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E.dl \cos \phi$$
hay:
$$dA = \frac{q_0 q}{4\pi \epsilon \epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$



$$A = \int_{a}^{b} \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon\epsilon_{0}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon\epsilon_{0}} \int_{a}^{b} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon\epsilon_{0}} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_{a}}^{r_{b}} = \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon\epsilon_{0}r_{a}} - \frac{q_{0}q}{4\pi\epsilon\epsilon_{0}r_{b}}$$

♦ A ∉ dạng đường đi, chỉ ∈ điểm đầu và điểm cuối đoạn dịch chuyển!



1.5.2 Lưu số vector cường độ điện trường

A = 0 khi $r_a \equiv r_b \Rightarrow$ trường tĩnh điện là trường thế.

Tức là:
$$A = \oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Hay: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$ gọi là *lưu số của vector cường độ điện trường*)

 \blacklozenge Lưu số của \vec{E} dọc theo đường kín = 0!

1.5.3 Thế năng trường tĩnh điện

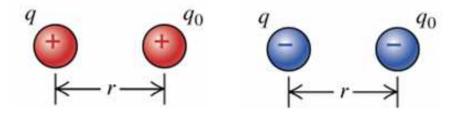
Dối với trường thế: Công của lực trong trường = độ giảm thế năng

Tức là:
$$A = W_a - W_b = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_a} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_b}$$

• $W = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$ \Rightarrow Thế năng của điện tích q_0 trong trường tĩnh điện của điện tích q tại 1 điểm nào đó có giá trị bằng công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển q_0 từ điểm đó ra vô cùng.

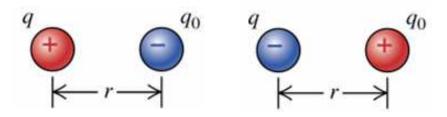
1.5.3 Thế năng trường tĩnh điện

Thế năng trong trường của 2 điện tích cùng dấu

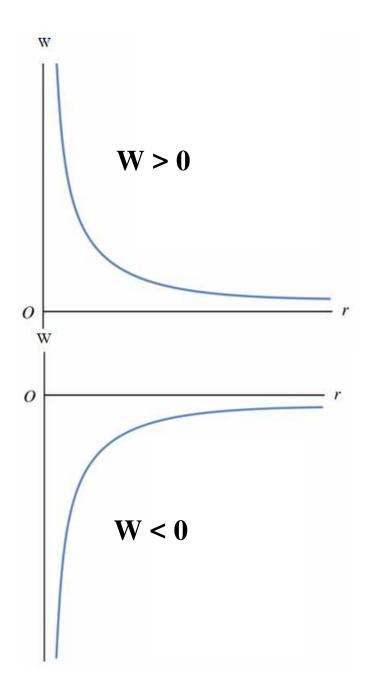


$$q_0 q > 0 \Longrightarrow F > 0 \text{ do } F = \frac{\partial W}{\partial r} \Longrightarrow W > 0$$

Thế năng trong trường của 2 điện tích trái dấu



$$q_0 q < 0 \Rightarrow F < 0 \text{ do } F = \frac{\partial W}{\partial r} \Rightarrow W < 0$$



1.5.4 Điện thế và hiệu điện thế

Công lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích từ r_a ra vô cực: $A_{a\infty} = \frac{q_0 q}{4\pi \epsilon \epsilon_0 r_a}$

có:
$$V_a = \frac{A_{a\infty}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_a} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r_a}$$
 gọi là điện thể của điện tích q tại vị trí r_a

- ♦ V_a chỉ ∈ điện tích q gây ra trường và vị trí xét trong trường.
- ♦ Điện thế tại 1 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1C từ điểm đó ra xa vô cùng.
- Nếu di chuyển q_0 giữa a và b, có: $\frac{A_{ab}}{q_0} = \frac{W_a}{q_0} \frac{W_b}{q_0} = V_a V_b$
- ♦ Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1 giữa 2 điểm đó.
- Công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích giữa 2 điểm: $A_{ab} = q_0(V_a V_b)$
- Ton vị của điện thế và hiệu điện thế: V (Volt)

1.5.4 Điện thế và hiệu điện thế

Trường hợp hệ điện tích phân bố rời rạc

- \mathcal{F} Xét q_0 dịch chuyển trong trường gây bởi q_1, q_2 và q_3
- Lực điện trường tổng hợp, $\vec{F} = \sum_{i=1}^{3} \vec{F}_{i}$
- ♦ Công của lực điện trường tổng hợp để q_0 dịch chuyển từ M → N

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} \, d\vec{l} = \sum_{i=1}^{3} \int_{M}^{N} \vec{F}_{i} \, d\vec{l} = \sum_{i=1}^{3} \left(\frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iM}} - \frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iN}} \right)^{\mathbf{M}} q_{0}$$

➡ Điện thế gây bởi hệ 3 điện tích tại M:

$$\frac{A_{M^{\infty}}}{q_0} = V_M = \frac{q_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{1M}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{2M}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{3M}} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{3M}} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{r_{iM}} = V_{1M} + V_{2M} + V_{3M}$$

 $\ \ \,$ Điện thế gây bởi hệ n điện tích tại M: $V_M = V_{1M} + V_{2M} + ... + V_{nM}$

1.5.4 Điện thế và hiệu điện thế

Trường hợp vật có phân bố điện tích (q) liên tục

- Thia vật thành vô số các phần tử điện tích dq (coi như điện tích điểm)
- Điện thế gây bởi dq: $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$ (r là khoảng cách từ dq đến điểm xét M)
- Thiện thế gây bởi vật tích điện tại M: $V_M = \int_{toàn hô vật} dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{toàn hô vật} \frac{dq}{r}$

Trường hợp q_o dịch chuyển trong trường điện tĩch bất kỳ

 $\ ^{\circ}$ Công của lực tĩnh điện khi di chuyển điện tích từ $M \to N$:

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} . d\vec{l} = \int_{M}^{N} q_{0} \vec{E} . d\vec{l} = W_{M} - W_{N}$$

 $^{\circ}$ Công của lực tĩnh điện khi di chuyển điện tích từ $M \to \infty$:

$$A_{M\infty} = W_M = \int_{M}^{\infty} \vec{F} . d\vec{l} = \int_{M}^{\infty} q_0 \vec{E} . d\vec{l}$$

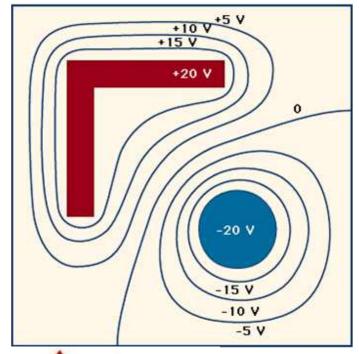
 $A_{M\infty} = W_M = \int_M^\infty \vec{F}.d\vec{l} = \int_M^\infty q_0 \vec{E}.d\vec{l}$ $\bullet \text{ Diện thế tại } M: V_M = \frac{A_{M\infty}}{q_0} == \int_M^\infty \vec{E}.d\vec{l} \text{ và hiệu điện thế: } V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q_0} == \int_M^N \vec{E}.d\vec{l}$

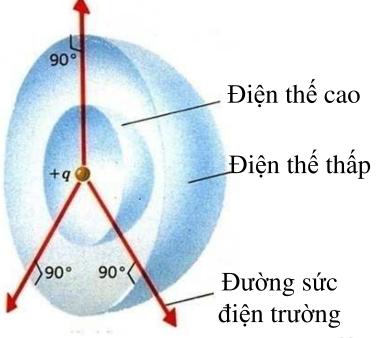
1.5.5 Mặt đẳng thế

- Khái niệm
- ♦ Qũi tích của những điểm có cùng điện thế.
- ♦ Được mô tả bằng những đường đồng mức 2 chiều, mỗi điểm trên đó biểu diễn cùng 1 giá trị điện thế (hình ảnh nhận được giống như bản đồ địa hình).

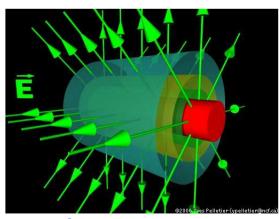
$$V(x,y,z) = C$$

- Tính chất
- lacktriangle Công lực tĩnh điện khi dịch chuyển 1 điện tích trên mặt đẳng thế, $A_{\rm MN}=q_0(V_{\rm M}-V_{\rm N})=0$,
- Vector \vec{E} tại mỗi điểm trên mặt đẳng thế \perp mặt đẳng thế tại điểm đó,
- ♦ Các mặt đẳng thế không cắt nhau,
- ♦ Mật độ đường đẳng thế xác định cường độ điện trường.

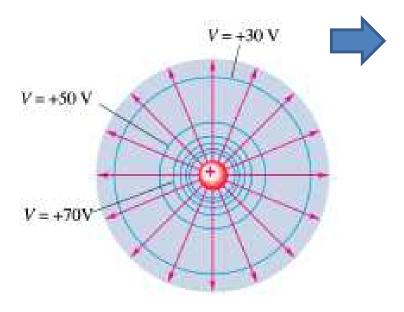




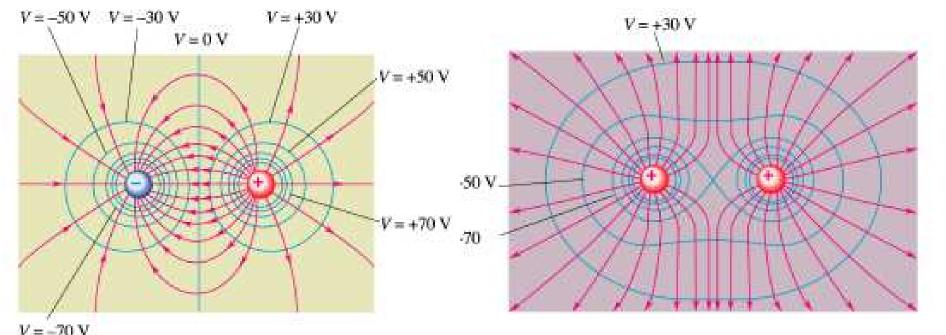
1.5.5 Mặt đẳng thế



Mặt đẳng thế quanh dây tích điện đều



Mặt đẳng thế quanh điện tích dương



Mặt đẳng thế quanh lưỡng cực điện

Mặt đẳng thế quanh hệ 2 điện tích điểm

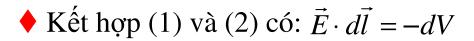
1. 6. Cường độ điện trường và điện thế

1.6.1 Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

- The Xét điện tích q_0 trong điện trường \vec{E}
- ♦ Công vi phân lực điện trường thực hiện để dịch chuyển q_0 từ M (có điện thế V) → N (điện thế V+dV). tương ứng khoảng cách dl:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \tag{1}$$

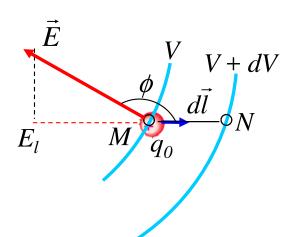
Mặt khác: $dA = q_0[V - (V + dV)] = -q_0 dV$ (2)



vì
$$dV > 0 \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{l} = E.dl \cos \phi = -dV < 0$$

- \blacklozenge Nghĩa là $\cos \phi < 0 \Rightarrow \phi$ là góc tù: vector \vec{E} luôn hướng về phía điện thế giảm!
- $F.cos\phi$ chính là hình chiếu của vector điện trường \vec{E} lên phương dịch chuyển dl tức là: $E.cos\phi.dl = E_l.dl = -dV$

$$\Rightarrow E_l = -\frac{dV}{dl}$$



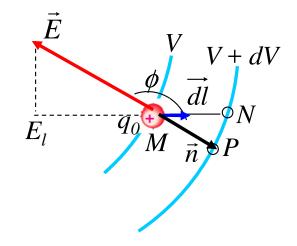
1. 6. Cường độ điện trường và điện thê

1.6.1 Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

Có thể viết:
$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$
; $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$; $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

$$\stackrel{\text{\sim}}{}$$
 Xét điểm $P: \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{n} \implies E_n = E = -\frac{\partial V}{\partial n}$

♦ Cường độ điện trường tại 1 điểm trong trường có trị số bằng độ biến thiên của điện thế trên 1 đơn vị khoảng cách lấy dọc theo pháp tuyến với mặt đẳng thế đi qua điểm đó.



 $\bullet \quad E_l = E cos \phi \leq E \implies \left| \frac{\partial V}{\partial l} \right| \leq \left| \frac{\partial V}{\partial n} \right| \quad \text{Diện trường lấy dọc theo pháp tuyến với} \\ \text{mặt đẳng thế luôn có giá trị lớn nhất.}$

1.6 Cường độ điện trường và điện thế

1.6.2 Hiệu điện thế đối với vật tích điện

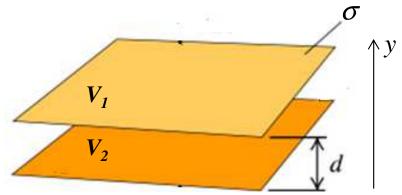
Thai mặt phẳng vô hạn mật độ điện mặt (σ) đều, điện thế trên mỗi mặt V_1 và V_2 , cách nhau một khoảng d.

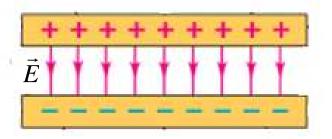
$$dV = -Edy \Rightarrow \int_{V_1}^{V_2} dV = -\int_{0}^{d} Edy$$

Điện trường giữa 2 mặt: $E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$

$$\Rightarrow$$
 có: $U = V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\varepsilon \varepsilon_0}$

- Pịnh nghĩa đơn vị cường độ điện trường
- ♦ V/m là cường độ điện trường của một điện trường đều mà hiệu thế dọc theo mỗi mét đường sức bằng một Vôn (Volt).





1.6 Cường độ điện trường và điện thế

1.6.2 Hiệu điện thế đối với vật tích điện

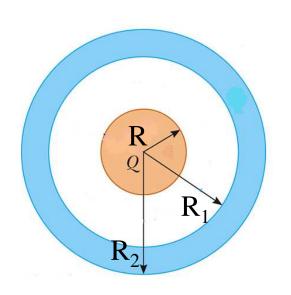
- $\ ^{\circ }$ Mặt cầu tích điện đều Q, bán kính R.
- igoplus Độ giảm điện thế giữa 2 điểm nằm trên 2 mặt cầu, bán kính R_1 và R_2 ($R_2 > R_1 > R$) với điện thế tương ứng V_1 , V_2 là:

$$-dV = Edr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$\int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$\Rightarrow co: U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

• Khi
$$R_1 = R$$
, $R_2 \rightarrow \infty$ $(V_2 = 0) \Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$



1.6 Cường độ điện trường và điện thế

1.6.2 Hiệu điện thế đối với vật tích điện

Thiệt trụ tích điện đều, mật độ điện mặt σ , bán kính $R \Rightarrow$ hiệu điện thế giữa 2 điểm tương ứng 2 mặt trụ, bán kính R_1 và R_2 là:

$$V_1 - V_2 = \int_{V_1}^{V_2} - dV = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \ln \frac{R_1}{R_2}$$

- Tưỡng cực điện (cặp 2 điện tích +q và -q cách nhau khoảng d)
- igoplus Điện thế tại $M(r, r_1, r_2 >> d)$

$$V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_1} + \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}\right)$$

với:
$$r_1 - r_2 = d.\cos\alpha$$
 và $r_1.r_2 = r^2$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{qd\cos\alpha}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{p_e\cos\alpha}{r^2}$$

